

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**  
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  
**младшего научного сотрудника**  
в лаборатории оптики кристаллов и гетероструктур с экстремальной двумерностью  
***Вакансия VAC\_PTI\_22002***

**Тематика исследований**

Разработка технологий плазменного травления и создания различных контактов к гетероструктурам широкозонных полупроводников для оптоэлектронных приборов среднего ультрафиолетового диапазона.

**Трудовая деятельность**

Участие в научных исследованиях по разработке полупроводниковых фотоприемных и светоизлучающих структур в составе коллектива лаборатории, включая:

- исследование сопротивления омических контактов к слоям AlGaN ( $Al > 0,6$ );
- исследование механизмов травления дислокаций в слоях GaN, AlGaN, AlN с различной полярностью и выращенных в различных условиях;
- исследование структурных свойств гетероструктур путем химического травления;
- полный цикл постростовых технологических операций. Таких как нанесение металлизации, химическое травление, ICP травление, гальваническое осаждение металлов;
- исследование структурных свойств с использованием растрового электронного микроскопа;
- исследования вольт-амперных характеристик, а так же иных выходных характеристик.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 23 800 руб.

СТАВКА: 0.5

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000 руб.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.